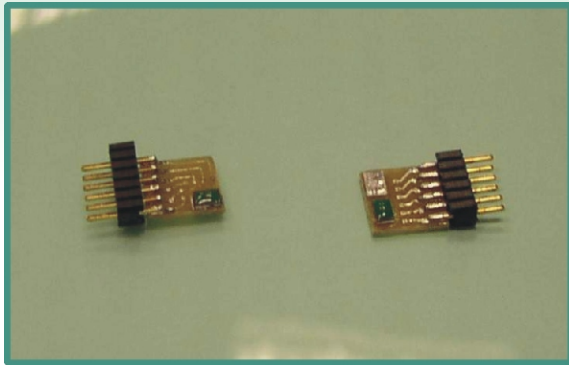


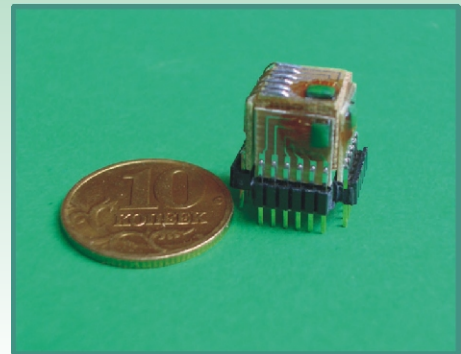
Матричный преобразователь диаграммы распределения магнитного поля на основе магниторезистивных датчиков

Области применения:

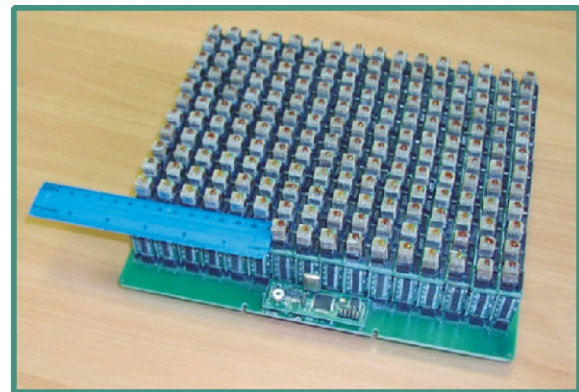
- детекторы наличия, ориентации, перемещения ферромагнитных объектов;
- магнитовизоры;
- дефектоскопы ферромагнитных объектов.



**Миниатюрные
магниторезистивные
датчики**



**Трёхкоординатный
магниторезистивный датчик**



Матрица АМРД-НХ

Основные технические
характеристики магниторезистивных датчиков:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМРД-НХ:

Напряжение питания, В	5 - 20
Сопротивление моста, Ом	1000 - 1300
Относительная чувствительность по магнитному полю, мВ/(В*Э)	0,15 - 0,2
Начальное смещение моста (технологический разбаланс моста), мВ/В	до ±5
Максимальная величина измеряемого поля, Э	до 10
Температурный дрейф нулевого сигнала, мкВ/°С	1 - 5
Температурный дрейф, %/°С	0,05 - 0,2
Ток подмагничивания, мА	100